









|  |  |
|--|--|
|   | <p><b>SIHB22N60S-GE3</b></p>   |
|  <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p> | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHB22N60S-GE3</a></p>   |
|  | <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p>   |
|  | <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V TO263</p>  |
|  | <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHB22N60S-GE3.pdf</a></p> |
|  | <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>   |
|  | <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 100 pcs Stock Available.</p>   |
|  | <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>   |
| <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>  |  |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">SIHB22N60S-GE3</a>  |
| Hersteller                                       | <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>                                      |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 650V TO263  |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | 100 pcs Stock   |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | ±30V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | D <sup>2</sup> PAK (TO-263)   |
| Serie  | S   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 190 mOhm @ 11A, 10V   |
| Verlustleistung (max)                            | 250W (Tc)   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB                            |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 2.81nF @ 25V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 110nC @ 10V   |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 600V  |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 600V 22A (Tc) 250W (Tc) Surface Mount                                   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 22A (Tc)  |

SIHB22N60S-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB22N60S-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB22N60S-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SIHB22N60S-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>SIHB22N60E-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 600V 23A D2PAK</p>  |  <p><b>SIHB22N60ET5-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 600V 21A TO263</p> |  <p><b>SIHB22N60S-E3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 600V 22A D2PAK</p> |  <p><b>SIHB22N65E-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 650V 22A D2PAK</p>             |
|  <p><b>SIHB22N60ET1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 600V 21A TO263</p> |  <p><b>SIHB22N60S-GE3</b><br/>VISHAY<br/>VISHAY TO263</p>                                       |  <p><b>SIHB22N60S-E3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 600V 22A D2PAK</p> |  <p><b>SIHB23N60E-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 600V 23A D2PAK</p> |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|   |  |   |                                      |   |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</a> | <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Datenblatt</a>  | <a href="#">SIHB22N60S-GE3-Datenblätter</a> | <a href="#">SIHB22N60S-GE3 PDF</a>   | <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay SIHB22N60S-GE3</a> |
| <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Electronic</a>                   | <a href="#">SIHB22N60S-GE3-Komponenten</a> | <a href="#">SIHB22N60S-GE3-Verteiler</a>    | <a href="#">SIHB22N60S-GE3-Bild</a>  | <a href="#">SIHB22N60S-GE3-Teil</a>                         |
| <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Preis</a>                        | <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Hersteller</a>  | <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Bild</a>         | <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Aktie</a> | <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Inventar</a>                     |
| <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Neu</a>                          | <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Original</a>    | <a href="#">SIHB22N60S-GE3 garantiert</a>   | <a href="#">SIHB22N60S-GE3 RFQ</a>   | <a href="#">SIHB22N60S-GE3 Online bestellen</a>             |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited